Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана Факультет «Радиоэлектроника и лазерная техника» Кафедра «Радиоэлектронные системы и устройства»

Семинар №1

по дисциплине

«Электроника»

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ВАХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ

Выполнили студенты группы РЛ-41 Филимонов С.В. Мухин Г. А. Сиятелев А.Ю.

Фамилия И.О.

Проверил проф. Крайний В.И.

Оценка в баллах_____

Сокращения терминов и аббревиатур:

ВАХ - Вольт амперная характеристика

MC - Micro-CAP12

Цель работы:

Моделирование лабораторных исследований программах моделирования, схемотехнического расчёт параметров модели ПО результатам моделирования. Приобретение навыков использовании базовых возможностей программ схемотехнического анализа ДЛЯ исследования статических И динамических характеристик полупроводниковых диодов с последующим расчётом параметров модели полупроводникового диода. Приобретение навыков В исследовании полупроводниковых приборов и освоение математических программ расчёта параметров модели полупроводниковых приборов на основе проведённых экспериментальных исследований.

Начальные данные

Диод модели: KD204B

R1: 1 Ом

R2: 5000 Ом

V1: 1 B

Ход работы

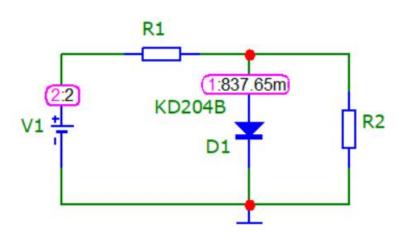


Рис. 1 Схема

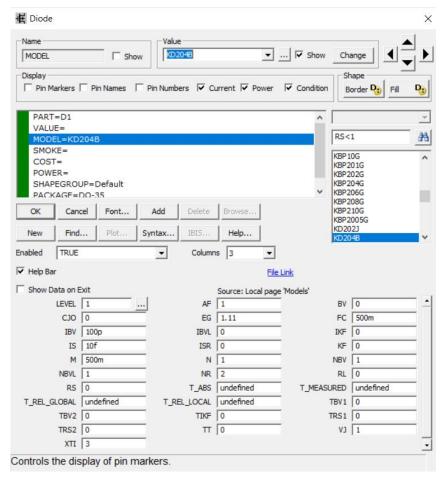


Рис.2 Описание диода в программе МС

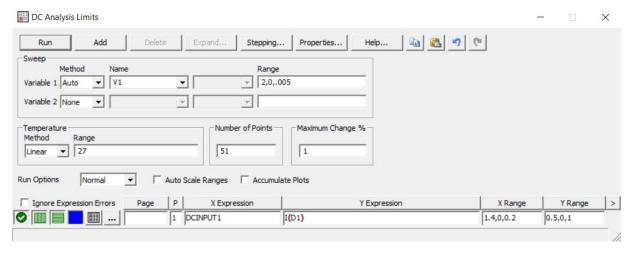


Рис.3 DC Analysyis Limits

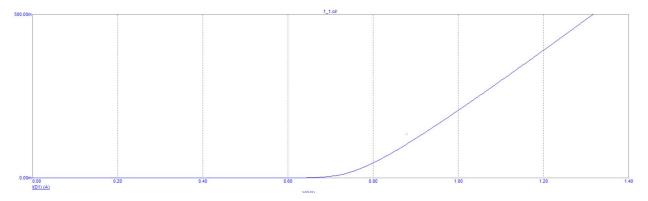


Рис.4 BAX прямой ветви

Проводим многовариантный анализ(stepping)для R2 = 1K..10K, R1 = 1..10 Ом.

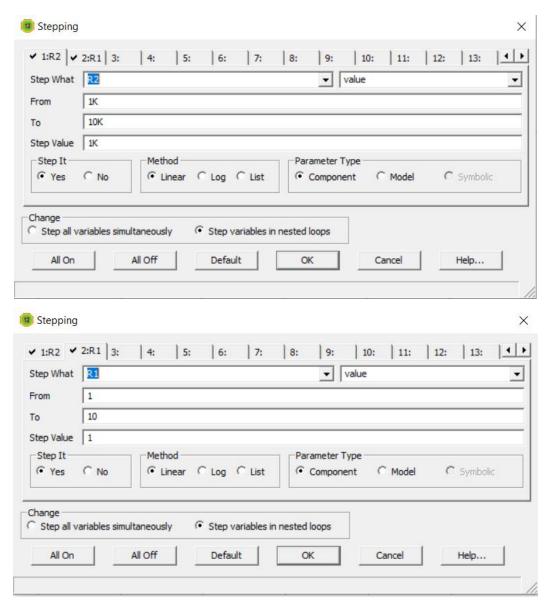


Рис.5 Настройка Stepping

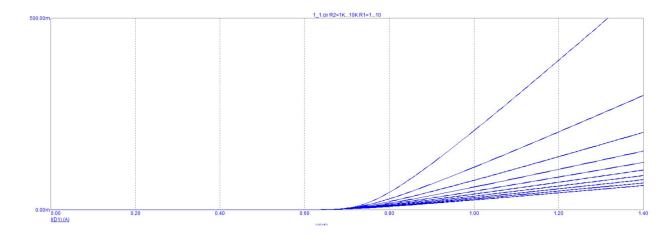


Рис. 6 График ВАХ ичении величины сопротивления Б

Для R1=1..10 Ом. При увеличении величины сопротивления R1 BAX смещается из-за увеличения падения напряжения на R1.

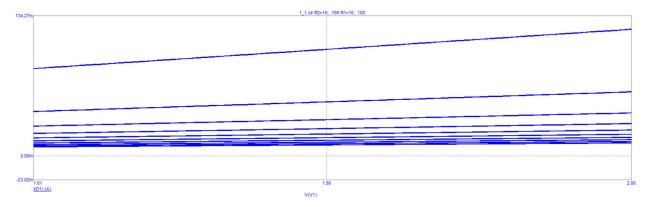


Рис. 7 R1 увеличивается

Графики расположены очень близко друг к другу поскольку сопротивления R2 и диод включены параллельно и $R_{\text{диода}} << R2$.

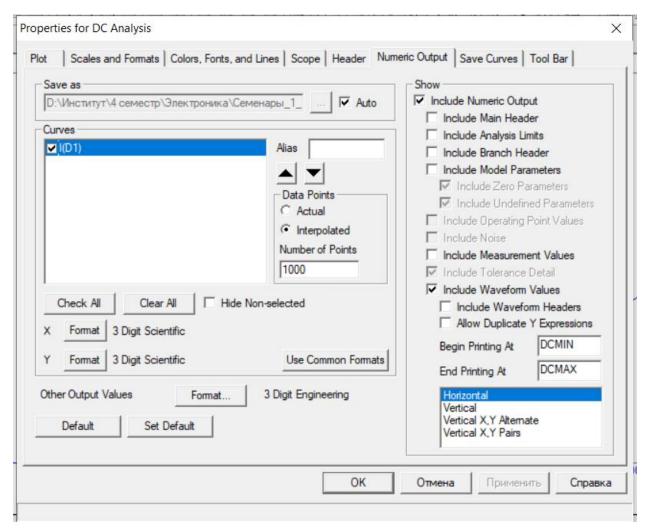


Рис. 8 Настройка для сохранения точек.

```
V(V1)
              I (D1)
                (A)
0.000E+00 1.000E-50
2.002E-03 2.855E-15
4.004E-03 5.711E-15
6.006E-03 8.657E-15
8.008E-03
          1.169E-14
1.001E-02
          1.473E-14
1.201E-02
          1.799E-14
1.401E-02
          2.124E-14
1.602E-02 2.465E-14
1.802E-02 2.817E-14
2.002E-02
          3.170E-14
2.202E-02 3.555E-14
2.402E-02 3.939E-14
2.603E-02
          4.346E-14
2.803E-02 4.771E-14
3.003E-02 5.195E-14
3.203E-02
          5.667E-14
3.403E-02
          6.139E-14
3.604E-02
          6.644E-14
3.804E-02
          7.174E-14
          7.705E-14
4.004E-02
4.204E-02 8.305E-14
4.404E-02
          8.906E-14
4.605E-02
          9.554E-14
4.805E-02 1.024E-13
```

Рис.9 Точки

$$Rb = 1.106$$

$$Is = 1.331*10^{-8}$$

NFt = 0.044

$$F(x) := x \cdot Rb + \ln\left[\frac{(IS + x)}{IS}\right] \cdot NFt.$$

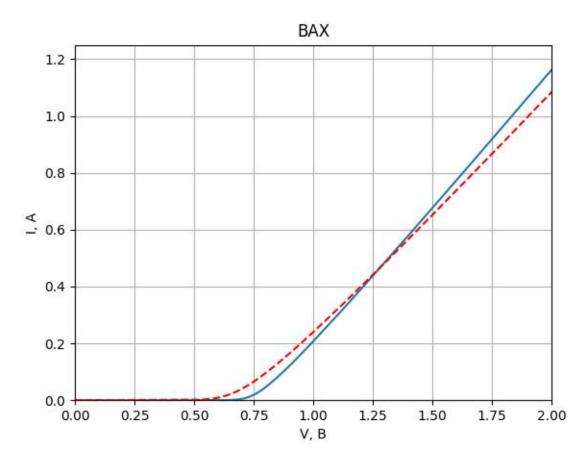


Рис. 10 Вах теоретический

График обратной ветви ВАХ.

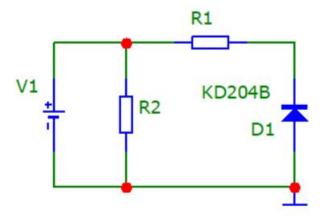


Рис. 1 Схема

Строим обратную ветвь BAX диода. Диалоговое окно задания параметров для построения BAX следующее:

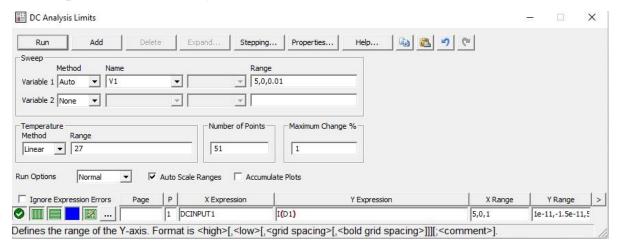


Рис. 2 Настройка пределов

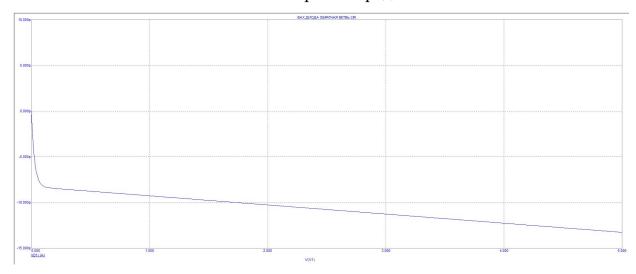


Рис. 3 График обратного ВАХ

Вывод.

Мы научились пользоваться программой МС. Провели теоретическое и практическое исследование полупроводникового диода KD204B.